

Lundi 2  
octobre 13h30 - 15h30

**Axe 2 : Intégration monolithique hétérogène et hétéroépitaxie sur silicium**

Yvon Cordier ; Charles Cornet ; Guillaume Saint-Girons

13h30 - 14h	Thierry Baron	In, Ga (As, Sb) heteroepitaxy on blanket and patterned Si(100) 300 mm substrates by MOCVD and their physical properties
14h - 14h30	Moustafa El-kurdi	Germanium à bande interdite directe pour l'intégration de sources optiques sur silicium
14h30 - 15h	Charbonnier Simon	GaP/Si(001) polar-on-nonpolar epitaxial growth revisited by scanning tunneling microscopy
15h - 15h30	Marc Portail	Croissance par CVD de SiC sur des films minces d'AlN sur Si(111) : une hétérostructure originale pour des applications MEMS ?

15h30 - 16h: PAUSE CAFÉ

16h - 18h

**Axe 3 : Organisation sur substrat fonctionnalisé et nanostructuré, croissance sélective et épitaxie latérale**

Yamina André ; Ludovice Desplanque ; Xavier Wallart

16h - 16h30	Pierre Ferret	Épitaxie Sélective en MOCVD et cas particuliers du GaN
16h30 - 17h	Charles Renard	Croissance sélective de $\mu$ -cristaux de GaAs sur Si
17h - 17h20	Alexandre Bucamp	Croissance sélective de nanofils planaires d'InGaAs sur substrat d'InP par épitaxie par jet moléculaire
17h20 - 17h40	Stefano Curiotto	Nano-droplets on a foreign substrate
17h40 - 18h	Geoffrey Avit	Selective area growth of GaN by Hydride Vapor Phase Epitaxy

18h - 18h15: PAUSE

18h15 - 19h : PRÉSENTATION DES POSTERS

Mardi 3 octobre 9h - 11h		
<b>Axe 4 : Caractérisations ultimes : locales, microscopiques et globales</b> Patrick Le Fevre ; Gilles Renaud ; Philippe Venegues		
9h - 9h40	Dominik Kriegner	rayons X synchrotron sur semi-conducteurs
9h40 - 10h	Anne Ponchet	Analyse chimique quantitative de couches AlSb nanométriques et subnanométriques dans l'hétérostructure [InAs/AlSb]
10h - 10h20	Williams Lefevre	Correlative investigations by HAADF-STEM and Atom Probe Tomography
10h20 - 11h	Christian Mocuta	Mesures de texture via les figures de pôles rapides en utilisant des détecteurs bidimensionnels sur la ligne de lumière DiffAbs (Synchrotron SOLEIL)
11h - 11h30 : PAUSE CAFÉ		
11h30 - 12h30		
<b>Axe 5 : Nouvelles techniques instrumentales liées à l'épitaxie et nouveaux systèmes</b> Alexandre Arnoult, Paola Atkinson, Antoine Ronda		
11h30 - 12h	Yvon Cordier	Mesure in-situ de la courbure : un outil pour l'hétéroépitaxie
12h - 12h30	Alexandre Arnoult	Mesures in-situ pour la croissance de structures complexes : retour d'expérience sur le BandIT
12h30-14h : DÉJEUNER		
14h - 15h		
<b>Axe 5 : Nouvelles techniques instrumentales liées à l'épitaxie et nouveaux systèmes</b> Alexandre Arnoult, Paola Atkinson, Antoine Ronda		
14h - 14h20	Thomas Gaudy ; société Hid SYSTEMES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET CARACTÉRISATION DES PROCESSUS MBE	
<b>GDR et FÉDÉRATION</b>		
14h20 - 15h	Isabelle Berbezier	Une fédération sur l'épitaxie ?
15h-16h		
<b>Axe 6 : Propriétés (optiques, électroniques, etc.) des systèmes épitaxiés et applications</b> Michele Amato, Hélène Carrere, Noëlle Gogneau		
15h - 15h30	Nikoletta Jegenyés	Piezoelectric properties of III-Nitride nanowires
15h30 - 16h	Laurent Lombez	Caractérisation de dispositifs optoélectroniques par imagerie de luminescence
16h-16h30 : PAUSE CAFÉ		
<b>Axe 6 : Propriétés (optiques, électroniques, etc.) des systèmes épitaxiés et applications</b> Michele Amato, Hélène Carrere, Noëlle Gogneau		
16h30 - 17h	Vincent Consonni	Croissance ZnO et propriétés optiques
17h - 17h30	Martina Morassi	Growth of In-rich InGaN/GaN nanowires for nano-energy applications
17h30-19h : SESSION POSTER 1		
DINER du GDR		

Mercredi 4  
octobre

9h-11h15

**Axe 7 : Nouveaux matériaux semiconducteurs (oxydes, organiques) et nouveaux systèmes 2D**

Mathieu Jamet, Holger Vach, Dominique Vignaud

9h - 9h30  
9h30 - 9h45  
9h45 - 10h  
10h - 10h30  
10h30 - 10h45  
10h45 - 11h15

Abdelkarim Ouerghi (C2N) Hétérostructures à base de matériaux bidimensionnels  
Roberto Sant (Institut Néel) Synchrotron X-ray exploration of growth and structure in 2D dichalcogenides  
Carlos Alvarez Study of 2D materials at van der Waals interface  
Hamid Oughaddou Silicene : a new 2D material  
Fatme Jardali Formation of silicene and germanene nanosheets on graphite: combined theoretical and experimental verifications  
Sanjay Mathur Phase and Morphology Engineering of Plasma CVD Grown Hexagonal Boron Nitride (*h*-BN)

11h15-11h45 : PAUSE CAFÉ

11h45-12h30

**Axe 8 : Nanofil 1**

Sébastien Plissard

11h45 - 12h15  
12h15 - 12h30

Maria Tchernycheva & Ludovic Largeau GaN nanowires grown on graphene substrates  
Vincent Sallet ZnO nanowire facets transformation induced by Ga doping

12h30-14h : DÉJEUNER

14h-15h15

**Axe 8 : Nanofil 1**

Sébastien Plissard

14h - 14h30  
14h30 - 15h  
15h - 15h15

Gilles Patriarche Observation in-situ dans un microscope électronique à transmission de la croissance par Epitaxie par Jets Moléculaires de nanostructures de semiconducteurs III-V  
Moïra Hocevar AXIAL InGaAs/GaAs NANOWIRE HETEROSTRUCTURES : GROWTH AND STRAIN DISTRIBUTION  
Edith Bellet-Amalric Croissance et sublimation de nanofils: boîtes quantiques CdTe dans ZnTe

15h15 - 15h45 : PAUSE CAFÉ

15h45 - 16h45

**Axe 1 : Modélisation et couplage entre théorie et expérience**

Pierre Müller, Olivier Pierre-Louis, Laurent Pizzagalli

15h45 - 16h15  
16h15 - 16h45

Cédric Mastail Coupling Approach Towards a Multiscale modelling of the growth hard Coatings (Ti-Al-N) thin film using the Kinetic Monte - Carlo approaches DFT Calculations  
Olivier Pierre-Louis Two stories on kinetic roughening: non-equilibrium cluster diffusion and interface collisions

16h45 - 17h : PAUSE

17h-19h : SESSION POSTER 2